








	<h2 style="color: #C00000;">SI5858DU-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5858DU-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI5858DU-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5858DU-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 8.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5858DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5858DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5858DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5858DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5857DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5902BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5858DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5902BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8</p>
 <p>SI5858DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5902BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5858DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5857DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5858DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI5858DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5858DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5858DU-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5858DU-T1-GE3
SI5858DU-T1-GE3 Electronic	SI5858DU-T1-GE3-Komponenten	SI5858DU-T1-GE3-Verteiler	SI5858DU-T1-GE3-Bild	SI5858DU-T1-GE3-Teil
SI5858DU-T1-GE3 Preis	SI5858DU-T1-GE3 Hersteller	SI5858DU-T1-GE3 Bild	SI5858DU-T1-GE3 Aktie	SI5858DU-T1-GE3 Inventar
SI5858DU-T1-GE3 Neu	SI5858DU-T1-GE3 Original	SI5858DU-T1-GE3 garantiert	SI5858DU-T1-GE3 RFQ	SI5858DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited